

خصائص موحد السيليكون

Diode Characteristics

الأهداف :

- 1 - لدراسة خواص الديايد ثبائي الوصلة
- 2 - لرسم منحنى خواص الجهد والتيار للموحد

الأجهزة المستخدمة :

1 - وحدة التجارب الرئيسية kl- 21001

2 - كرت التجربة رقم kl-13007

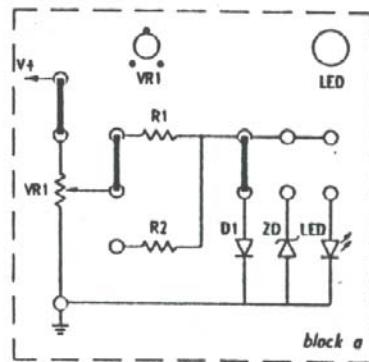
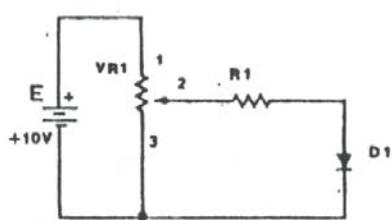
3 - جهاز افوميتر + راسم الاشارة + اسلاك توصيل

خطوات التجربة :

1 - ضع كرت التجربة رقم KL-13007 على اللوحة الرئيسية للتجارب KL-21001 وحدد

a المربع

2 - وصل الدائرة كما بالشكل أدناه باستخدام الكلبسات.



3 - اضبط مصدر الجهد المستمر على 10V+ بواسطة جهاز الأفوميتر. وصله إلى دخل الدائرة V

4 - استخدم الأفوميتر لقياس الجهد على المقاومة المتغيرة VR1 حيث تستخدم هذه المقاومة لضبط الجهد على طريق الموحد. كما تستخدم المقاومة R1 لحماية الموحد من التيار الزائد .

5 - انزع الكلبس الموصل بالتوازي مع الموحد وصل مكانه جهاز قياس التيار .

6 - غير في قيمة المقاومة VR1 حتى تحصل على قراءة للتيار في جهاز الأميترتساوي 0.1mA . ثم وصل جهاز قياس الجهد بالتوازي مع الموحد وسجل قيمة الجهد في الجدول أدناه.